

Sent: Friday, October 07, 2005, 3:55 AM

Subject: Re: 注意你的論文格式!!

XXX :

I was disappointed by your revised paper.

(1) 為何 Fig.2 and Fig.6 的 figure captions 對齊格式要跟其他 figure 的格式不同?

(2) 在第二頁,

Thus, the voltage at the source of the **cascode transistor** is about 0.6V. As long as the voltage at I/O PAD is **larger than 2.5V**, the drain-source voltage of the MN2 is larger than the normal supply voltage during the transient. This results in significant hot-carrier degradation.

cascode transistor 是那一個? 已經要你標示電晶體 MN1, MN2, 為何還在用一個不知道是指哪一個電晶體的用詞呢?

為何 I/O PAD is **larger than 2.5V** ==> results in significant hot-carrier degradation?

只有 **2.6V, 2.7V, ... (such voltage is larger than 2.5V)** 為何會有 **hot-carrier degradation**? 這是什麼理論? 你在寫什麼?

(3) In your new circuits (in Fig. 4, Fig.5, Fig.6(a)), 為何 two-stacked transistors 的電晶體編號 要跟 Fig.1 與 Fig.3 的不同? Fig.3 的電路就是 Fig. 4 的電路, 為何相同位置的電晶體要用不同的編號, 前面 e-mail 已經講過的『烏龜尾巴』, 你不了解嗎? 你的程度在哪裡?

三更半夜沒睡, 看到這種論文真的是會氣死人, 已經講過的還不會改?

注意同一電路中不要有相同的電晶體編號. 儘快修改圖式 並在相對文章的部份也要一併更正. 才四頁的科技短文, 就有一 bug 堆抓不完, 你以後的碩士論文幾十頁, 誰敢幫你改?

Ming-Dou Ker

=====